

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1686719932714/nr. 21082467 din data 04/07/2023****Obiectul de achiziției:Microscop electronic cu baleaj (SEM) (repetat)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Tara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Microscop electronic cu baleaj (SEM)	TESCAN VEGA	Repubica Cehă	TESCAN Brno, s.r.o	<p>Microscop electronic cu baleaj cu urmatoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Microscop controlat complet din computer cu filament de tungsten sau echivalent, atat pentru aplicatii in vid inalt cat si in vid slab</li> <li>- Rezolutie in vid inalt: min. 3nm la 30kV si min. 8nm la 3kV</li> <li>- Rezolutie in presiune variabila: 3.5nm la 30kV</li> <li>- Domeniu de marire de la 3x sau mai jos pana la cel putin 1 000 000x</li> <li>- Camp de vizualizare de cel putin 7mm la distanta de lucru de 10mm</li> <li>- Domeniu de energii al fasciculului de electroni: de la 200eV sau mai jos pana la cel putin 30keV</li> <li>- Current de proba de la 1pA sau mai jos pana la cel putin 2uA</li> <li>- Currentul de proba ajustabil continuu din interfata software, fara a fi nevoie de niciun fel de interventii mecanice (centrari) la coloana efectuate de utilizator.</li> <li>- Nu necesita sistem de aperturi pentru diferitele moduri de imagistica sau daca acestea sunt necesare atunci sunt incalzite cu scopul evitarii contaminarii acestora</li> <li>- Software pentru calcularea in timp real a dimensiunii spotului pe proba</li> <li>- Viteza de scanare de 20ms sau mai jos pana la cel putin 10ms per pixel ajustabil in pasi si continuu</li> <li>- Mod de vid inalt si mod de vid slab pana la cel putin 500Pa</li> <li>- Platam de probe cu miscare motorizata in axa X de cel putin 60mm, in axa Y de cel putin 60mm si rotatie continua 3600</li> </ul> <p>- Deplasarea pe axa Z de cel putin 50mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inclinarea stanga-dreapta de cel putin 800 pe fiecare directie</li> <li>- Inaltime maxima probe: cel putin 50mm</li> <li>- Detectori inclusi la livrare:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. detector de electroni secundari</li> <li>b. picoampermetru pentru masurarea currentului de proba</li> <li>c. alarma la atingere – opreste miscarea daca se produce vreo atingere in camera probei</li> </ul> </li> <li>- Dimensiune maxima imagine de cel putin 16k x 16k pixeli</li> </ul> <p>- Automatizari precum: ajustare continua dimensiune spot si curent, focalizare, astigmatism, contrast-stralucire, incalzire si centrage filament, centrage tun si coloana etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Software: masurari, procesare imagini etc.</li> <li>- Include PC cu monitor, tastatura si mouse si UPS</li> </ul> <p>Caracteristici specifice EDX:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detector de raze X fara azot lichid, rezolutie de 129eV sau mai buna,arie activa de cel putin 30mm<sup>2</sup></li> <li>- Software detector de raze X: sa permita analiza elementalala pe o regiune, pe un punct, pe o linie si cartografiere, creare de rapoarte de analiza. Caracteristici specifice EBL:</li> <li>- Software avansat pentru litografie cu electroni care sa poata genera forme geometrice, imagini tip bitmap, text, markere de aliniere conform EBL Kit Datasheet pag. 1</li> <li>- Timp de stationare minim pe pixel de 20ns/pixel sau mai mic pentru orice forma</li> <li>- Campuri multiple de scriere adiacenta (stitching)           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corectie efect de proximitate</li> </ul> </li> <li>- Import fisiere in formate universale GDSII si DXF</li> </ul>	<p>Microscop electronic cu baleaj cu urmatoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Microscop controlat complet din computer cu filament de tungsten atat pentru aplicatii in vid inalt cat si in vid slab, conform datasheet pag. 3</li> <li>- Rezolutie in vid inalt: 3nm la 30kV si 8nm la 3kV conform datasheet pag. 3</li> <li>- Rezolutie in presiune variabila: 3.5nm la 30kV conform datasheet pag. 3</li> <li>- Domeniu de marire de la 2x pana la 1 000 000x conform datasheet pag. 3</li> <li>- Camp de vizualizare de 7.7mm la distanta de lucru de 10mm conform datasheet pag. 3</li> <li>- Domeniu de energii al fasciculului de electroni: de la 200eV pana la 30keV conform datasheet pag. 3</li> <li>- Current de proba de la 1pA pana la 2uA conform datasheet pag. 3</li> </ul> <p>- Currentul de proba ajustabil continuu din interfata software, fara a fi nevoie de niciun fel de interventii mecanice (centrari) la coloana efectuate de utilizator.conform datasheet pag. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nu necesita sistem de aperturi pentru diferitele moduri de imagistica conform datasheet pag. 1</li> <li>- Software pentru calcularea in timp real a dimensiunii spotului pe proba conform brosura pag. 3</li> <li>- Viteza de scanare de 20ns pana la 10ms per pixel ajustabil in pasi si continuu conform datasheet pag. 3</li> <li>- Mod de vid inalt si mod de vid slab pana la cel putin 500Pa conform datasheet pag. 3</li> <li>- Platam de probe cu miscare motorizata in axa X de cel putin 60mm, in axa Y de cel putin 60mm si rotatie continua 360° conform datasheet pag. 3</li> </ul>	CE, ISO

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beam Blanker electrostatic sau echivalent pentru a bloca fasciculul de electroni intre obiectele individuale din structura care se scrie; Beam Blankerul electrostatic sau echivalent va putea fi folosit si pentru reducerea efectului de incarcare a suprafetei probelor neconductoare la imagistica SEM prin reducerea timpului de expunere pe pixel</li> <li>- Beam Blankerul va contine un dispozitiv de blocare a fasciculului de electroni (ex. ansamblu de doi electrozi) conectat la un amplificator rapid: 10MHz maxim. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Timp pentru blocare fascicul: &lt;=50ns tipic</li> <li>- Timp pentru iluminare: &lt;=50ns tipic</li> <li>- Timp de intarziere (delay): &lt;=80ns tipic</li> </ul> </li> <li>- Beam Blanker electromagnetic suplimentar (care foloseste bobinile coloanei SEM) inclus de asemenea, astfel incat prin combinarea beam blunkerului electromagnetic cu beam blunkerul electrostatic sa se evite posibilitatea ajungerii electronilor in alte zone decat cele de interes <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport special pentru proba de litografie</li> </ul> </li> <li>- Beam Blanker-ul va putea fi folosit pentru blocarea intermitenta a fasciculului in timpul achizitiei imaginii astfel incat sa se reduca expunerea probei la radiatia de electroni minimizand astfel efectul de incarcare electrostatica a probei;</li> <li>- Microscopul va controla beam blunkerul in mod automat astfel incat sa fie sincronizata miscarea fasciculului de electroni cu beam blunkerul pentru a obtine efectul de reducere a incarcarii electrostatice de pe suprafata probelor neconductoare in timpul imaginisticii de tip SEM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beam Blanker electrostatic pentru a bloca fasciculul de electroni intre obiectele individuale din structura care se scrie; Beam Blankerul electrostatic va putea fi folosit si pentru reducerea efectului de incarcare a suprafetei probelor neconductoare la imagistica SEM prin reducerea timpului de expunere pe pixel conform datasheet Beam Blanker pag. 1</li> <li>- Beam Blanker va contine un dispozitiv de blocare a fasciculului de electroni conectat la un amplificator rapid: 10MHz maxim.conform datasheet Beam Blanker pag. 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Timp pentru blocare fascicul: &lt;=50ns tipic conform datasheet Beam Blanker pag. 3</li> <li>- Timp pentru iluminare: &lt;=50ns tipic conform datasheet Beam Blanker pag. 3</li> <li>- Timp de intarziere (delay): &lt;=80ns tipic conform datasheet Beam Blanker pag. 3</li> </ul> </li> <li>- Beam Blanker electromagnetic suplimentar (care foloseste bobinile coloanei SEM) inclus de asemenea, astfel incat prin combinarea beam blunkerului electromagnetic cu beam blunkerul electrostatic sa se evite posibilitatea ajungerii electronilor in alte zone decat cele de interes conform datasheet Beam Blanker pag. 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport special pentru probe de litografie conform extras manual Sample Holder pag. 28</li> </ul> </li> <li>- Beam Blunker-ul va putea fi folosit pentru blocarea intermitenta a fasciculului in timpul achizitiei imaginii astfel incat sa se reduca expunerea probei la radiatia de electroni minimizand astfel efectul de incarcare electrostatica a probei; conform notei tehnice Beam Blunker reduction of charging effect</li> <li>- Microscopul va controla beam blunkerul in mod automat astfel incat sa fie sincronizata miscarea fasciculului de electroni cu beam blunkerul pentru a obtine efectul de reducere a incarcarii electrostatice de pe suprafata probelor neconductoare in timpul imaginisticii de tip SEM</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beam Blunkerul va putea fi folosit pentru litografie cu electroni</li> <li>- Suport probe special pentru litografie, cu 3 pozitii: a. pozitia pentru probe: va putea acomoda probe cu dimensiunea laterală de <math>\geq 2''</math>; b. pozitia pentru Faraday Cup: va contine un Faraday cup integrat permanent pentru a putea masura curentul de proba si deci calcula doza de iradiere; c. pozitia pentru proba standard: va contine o proba de tip aur pe carbon montata permanent pentru a putea face toate ajustarile fasciculului (focalizare, astigmatism etc.)</li> <li>- Acuratetea platoului microscopului de <math>\pm 2\mu m</math> nu este afectata.</li> <li>- Kit de accesorii si consumabile specifice pentru litografie de electroni:</li> <li>- Software special pentru litografie cu electroni – specificatii tehnice:</li> <li>Poate prelua controlul microscopului SEM pentru a executa litografie cu electroni</li> <li>Moduri de procesare: EBL (electron beam lithography) Timp dwelling: &lt;=20ns/pixel</li> <li>Figuri posibile: punct/linie/cruce, dreptunghiuri (contur, dreptunghiuri pline, scari, polisare), cerc (contur, cerc plin), poligoane, imagini tip bitmap sau echivalent, text, obiecte goale (dreptunghiuri, cercuri, poligoane), marcaje de aliniere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beam Blunkerul va putea fi folosit pentru litografie cu electroni conform datasheet Beam Blunker pag. 1</li> <li>- Suport probe special pentru litografie, cu 3 pozitii: a. pozitia pentru probe: va putea acomoda probe cu dimensiunea laterală de <math>2''</math>; b. pozitia pentru Faraday Cup: va contine un Faraday cup integrat permanent pentru a putea masura curentul de proba si deci calcula doza de iradiere; c. pozitia pentru proba standard: va contine o proba standard de tip aur pe carbon montata permanent pentru a putea face toate ajustarile fasciculului (focalizare, astigmatism etc.) conform document LithoBox pag. 2</li> <li>- Acuratetea platoului microscopului de <math>\pm 2\mu m</math> nu este afectata. conform document Tescan Compucentric Stage pag. 2</li> <li>- Kit de accesorii si consumabile specifice pentru litografie de electroni: conform document LithoBox</li> <li>- Software special pentru litografie cu electroni – specificatii tehnice:</li> <li>Poate prelua controlul microscopului SEM pentru a executa litografie cu electroni conform EBL Kit datasheet pag. 1</li> <li>Moduri de procesare: EBL (electron beam lithography) conform EBL Kit datasheet pag. 1 Timp dwelling: =20ns/pixel conform datasheet pag. 3</li> <li>Figuri posibile: punct/linie/cruce, dreptunghiuri (contur, dreptunghiuri pline, scari, polisare), cerc (contur, cerc plin), poligoane, imagini tip bitmap sau echivalent, text, obiecte goale (dreptunghiuri, cercuri, poligoane), marcaje de aliniere Conform extras manual DrawBeam Advanced pag. 3</li> </ul>
		<p>Obiecte aranjate pe straturi, fiecare strat avand propriul set de parametri de procesare</p> <p>Functii de editare precum: undo/redo, taiere/copiere/inserare/stergere, clonare obiecte, grupuri de obiecte, rotire si aliniere obiecte, management obiecte si straturi</p> <p>Sisteme de coordonate UV, aducere la nivel pe axa Z – corectie inclinare</p> <p>Scriere de campuri multiple (stitching), navigare pe platou, corectie de proximitate, import din fisiere universale precum GDSII si DXF, aliniere automata si manuala a figurilor;</p> <p>Permite scrierea in campuri echidistante si replicarea in oglinda a obiectelor.</p> <p>Oferta va include livrare la locul de instalare si instalarea produsului in locatie.</p> <p>Oferta va include si training pentru operatori, minim 3 zile la locatia beneficiarului.</p> <p>Garantie 24 luni.</p>	<p>Obiecte aranjate pe straturi, fiecare strat avand propriul set de parametri de procesare conform extras manual DrawBeam pag. 2</p> <p>Functii de editare precum: undo/redo, taiere/copiere/inserare/stergere, clonare obiecte, grupuri de obiecte, rotire si aliniere obiecte, management obiecte si straturi conform extras manual DrawBeam pag. 3</p> <p>Sisteme de coordonate UV, aducere la nivel pe axa Z – corectie inclinare conform extras manual Drawbeam pag. 18</p> <p>Scriere de campuri multiple (stitching), navigare pe platou, corectie de proximitate, import din fisiere universale precum GDSII si DXF, aliniere automata si manuala a figurilor; conform extras manual DrawBeam pag. 3</p> <p>Permite scrierea in campuri echidistante si replicarea in oglinda a obiectelor. conform extras manual DrawBeam pag. 24</p> <p>Oferta va include livrare la locul de instalare si instalarea produsului in locatie.</p> <p>Oferta va include si training pentru operatori, minim 3 zile la locatia beneficiarului.</p> <p>Garantie 24 luni.</p>
Total lot 1			
TOTAL			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23

CE, ISO